

تغییر مورفولوژی و بررسی ساختارهای کربنی

احمد قضاتلو^{۱*} و مجتبی شریعتی نیاسر^۲

۱- پژوهشگاه صنعت نفت، تهران

۲- آزمایشگاه پدیده های انتقال و فناوری نانو، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

ابتدا به تغییر مورفولوژی نانوساختارهای کربنی شامل فولرن، نانولوله های کربنی و گرافن پرداخته و سپس مطالعه ساختاری آنها مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده شد فرایند اکسیداسیون در نانوساختارهای کربنی تاثیر بسیار متعددی در مقدار تخلخل و زبری سطح دارند و در ساختار گرافن با سطح متخلف اثر گذاری کمتری از خود نشان می دهند. به عبارتی اثر فرایند اکسیداسیون بر قسمتی از سطوح نانوساختار بیشتر متوجه می گردد که دارای سطحی صاف تر باشد. این موضوع در گرافن خالص بسیار محسوس تر است زیرا سطح صفحات آن دارای صافی کافی می باشد درنتیجه فرایند اکسیداسیون $\frac{5}{2}$ % زبری سطح و $\frac{35}{2}$ % تخلخل را افزایش می دهد. در حالیکه گرافن هامرز 13% زبری بیشتر نسبت به گرافن خالص دارد. با توجه به بررسی های بعمل آمده و نتایج AFM از نانوساختارهای کربنی نتیجه می شود که فرایند عاملدار کردن در کنار مورفولوژی اولیه نانوساختار می تواند موجب افزایش تخلخل و زبری سطح شود و مقدار این افزایش کاملاً تابع میزان صافی سطح نانوساختار اولیه و هندسه چند بعدی آن می باشد. همچنین فرایندهای عاملدار کردن بر کاهش شدت پدیده کلسترینگ نانوذرات اثر مثبت دارند و کاهش اندازه ذرات نانوساختارها در کلسترها خود موجب افزایش تخلخل و زبری سطحی می شود. بنابراین فرایندهای عاملدار کردن می توانند مورفولوژی نانوذرات را به لحاظ ساختاری، خواص سطحی و هندسه بشدت تغییر داده و بر اساس این تغییرات رفتار متفاوتی از آن نانوساختار ارائه دهند.

واژه های کلیدی: فولرن، نانولوله کربنی، گرافن، مورفولوژی، زبری سطح

ایمیل نویسنده مسئول: ghozatlooa@ripi.ir

۱- مقدمه

استفاده از روش های مختلف پایداری و آبدوست کردن نانوذرات موجب ایجاد خواص سطحی جدیدی می شود و به موجب آن رفتار فیزیکی نانوذرات تغییر می کند. همچنین نانوذرات یکسانی وجود دارند که با هندسه های مختلف تولید می شوند و بر اساس آن عملکرد و اثر متفاوتی را از خود بروز می دهند. با توجه به اینکه نانوساختارهای کربنی اغلب دارای خاصیت آبگریزی هستند برای ایجاد پایداری آنها در آب از دو روش آبدوست کردن توسط سورفکتنت و روش اصلاح خواص سطحی استفاده می شود. بدینهی است زمانیکه از سورفکتنت برای پایداری نانوساختاری در آب استفاده شود مورفولوژی آن نانوساختار تغییر نمی کند. ولی زمانیکه توسط فرایندهای مختلف فیزیکی و شیمیائی خاصیت آبدوستی در آن ایجاد می گردد مورفولوژی نانوساختار تغییر می کند که این تغییر در رفتار نانوساختار تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. بنابراین سعی شده در این مقاله به نحوه بررسی تغییر مورفولوژی نانوساختارهای کربنی پرداخته شود و آنالیز های مختلفی که در این خصوص مورد استفاده قرار می گیرند شناسائی و به چگونگی تحلیل آنها مبادرت شود.

۲- اصلاح خواص سطحی نانوساختارهای کربنی
امروزه نانوساختارهای کربنی متفاوتی سنتز شده و در فرایندهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند که همگی از آلتوropی های اضافه کرده و به مدت سه ساعت در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد



بوده که برای این منظور می‌باشد نمونه‌ها در دمای 120°C و به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه در خلا حرارت داده شوند تا بخارآب، دی‌اکسیدکربن و یا سایر مولکولهایی که ممکن است حجم حفره‌های ماده را اشغال کرده باشند، حذف گردند. سپس نمونه‌ها تا ۷۷ درجه کلوین سرد شده و در معرض مقدار مشخصی از گاز نیتروژن قرار می‌گیرد و فرست برقاری تعادل ایجاد می‌شود. با توجه به فشار گاز به هنگام تعادل و با استفاده از رابطه گازها، مقدار گاز جذب شده محاسبه می‌شود.

تصاویر میکروسکوپ نیروی اتی (AFM) برای بررسی انواع سطوح و تعاملات بین ذرات کاربرد گستردگی دارد [۳]. در این میکروسکوپ یک باریکه میکرونی با قطر ۱۰۰ به عنوان یک قلم بسیار تیز عمل کرده و با قرار گیری در فاصله نزدیک به سطح نمونه، تصویر آنرا ترسیم می‌کند. این میکروسکوپ بدلیل استفاده از نیوهای اتمی‌مانند نیروی واندروالس برای آتالیز سطح می‌تواند توپوگرافی سطح تصویر فاز، خواص مغناطیسی، دانه بندی و ضخامت تک لایه را مورد بررسی قرار دهد.

۴- تجزیه و تحلیل نتایج

پس از انجام فرایندهای اصلاح خواص سطحی نانوساختارهای فولرن، CNT و گرافن آزمون‌های مشخصه یا و آنالیزهای مربوطه برای هر یک از آنها انجام و به بررسی وضعیت مورفوЛОژی آنها پرداخته شد.

۱۴- طیف سنجی نانوساختارهای کربنی

شکل (۱-الف) طیف XRD نانولوله‌های کربنی چند دیواره را پس از فرایند اکسیداسیون در محیط اسیدی نشان می‌دهد. از آنجائیکه طیف XRD نانولوله‌های کربنی چند دیواره که توسط روش اسیدی اکسید شده اند دارای یک پیک بلند و نسبتاً باریک در ناحیه $25/7$ درجه مربوط به دسته صفحات (۰۰۲) با فاصله 0.34 \AA نانومتر به دلیل ساختار هگزاگونال و یک پیک کوتاه و پهن در ناحیه $43/6$ درجه مربوط به دسته صفحات (۱۰۰) می‌باشد [۴] این پیک‌ها به خوبی مشهود است. گرافن در زاویه 26 درجه یک پیک کوتاه و پهن می‌دهد [۵]. اکسیدگرافن نیز در زاویه 12 درجه دارای یک پیک بلند و پهن است [۵]. پیک زاویه 26 درجه برای صفحات (۰۰۲) نماینده دسته صفحات با فاصله 0.34 \AA نانومتر و پیک زاویه $11/8$ درجه برای صفحات (۱۱۱) نماینده دسته صفحات با فاصله 0.749 \AA نانومتر است. شکل (۱-ب) و شکل (۱-ج) به مقایسه طیف XRD گرافن و اکسیدگرافن می‌پردازد و ملاحظه می‌شود که در فرایند اکسیداسیون گرافن پیک شاخص گرافن در زاویه 26 درجه ضمن باریکتر شدن به زاویه‌های کوچکتر در محدوده 11 درجه منتقل شده است و دارای کشیدگی بسیار زیادی است. بدین معنا که ساختار کریستالی گرافن کمی دچار بی نظمی شده است. بنابراین نتیجه می‌شود که طی فرایند اکسیداسیون ساختار کریستالی گرافن تغییر کرده و مورفوLOژی جدیدی در آن ایجاد شده است.

در ساختار کره‌ای فولرن پیک‌های نواحی 11 و 18 و 21 درجه به عنوان پیک‌های شاخص می‌باشند. این پیک‌ها به ترتیب نماینده دسته صفحات (۱۱۱) و (۰۰۲) و (۲۰۰) می‌باشند [۶].

اولتراسونیک می‌کنیم. سپس آنرا به کمک آب مقطر چند بار شسته تا pH آن به حالت خنثی درآید و در آون در دمای 50°C درجه‌سانتی‌گراد به مدت ۸ ساعت خشک می‌کنیم. پودر نرم و سیاه رنگ بدست آمده اکسیداسیدی نانوساختار استفاده شده است.

برای پایداری فولرن از روش آسیاب گلوله‌ای استفاده می‌شود. برای اصلاح سطحی فولرن ابتدا 1 g پودر فولرن در 500 cc ایزوپرپیل الکل ریخته و به مدت 4 روز در دمای محیط در دستگاه اولتراسونیک حمامی قرار می‌گیرد. سپس مخلوط حاصل را با نسبت وزنی گلوله به نمونه 10 به 1 برای آسیاب موثر در آسیاب گلوله‌ای سیارهای ریخته و با دور همزدن 50 rpm طی مدت زمان 72 ساعت آسیاب می‌گردد تا خوب در فاز مایع توزیع شود. سپس محلول حاصل به مدت 30 دقیقه توسط دستگاه اولتراسونیک قرار داده می‌شود. پس از آن پودر موجود در محلول به کمک سانتریفوج دور بالا از ایزوپرپیل الکل جدا شده و با آب دیوینزه شده سشتۀ می‌شود و در آون در دمای 35°C درجه سانتی‌گراد به مدت 5 ساعت خشک می‌شود. پودر فولرن خشک شده در آب دارای پایداری مناسبی است.

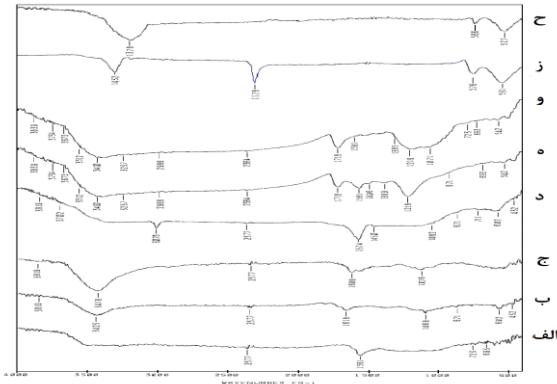
۳- آزمون مشخصه یا و آنالیز سطحی

هر اتم می‌تواند نور تابیده شده را جذب و یا یک فوتون جدید ساطع کند که هر دو از لحاظ فرکانس و نور تابیده شده اول، فاصله و تاخیر مشخصی دارند. از روی میزان این تاخیر و اندازه پیک‌ها می‌توان اطلاعات لازم را از نوع اتم و پیوندهای آن بدست آورد و ساختمان مولکول را تعیین و بررسی کرد. این دو پدیده اساس شناسایی و اندازه‌گیری مواد به روش "طیف سنجی" می‌باشد.

طول موج‌های پرتو X با فواصل بین اتم‌ها در مواد بلوری برابر است، بنابراین مواد بلوری برای پرتو X می‌توانند نقش پراش را ایفا کنند. طرح پراش ایجاد شده توسط یک جسم بلوری برای شناسایی آن جسم به کار می‌رود. با استفاده از این روش می‌توان اطلاعاتی در خصوص بلورینگی ساختار و نوع ماده بدست آورد. همچنین با استفاده از پهنهای پیک می‌توان اطلاعات مرتبط با اندازه کریستال‌ها را بدست آورد.

ترکیباتی که پیوندهای کوالانسی مختلفی دارند بر اساس پیوندشان فرکانس‌های متفاوتی از اشعه الکترومغناطیس را در ناحیه مادون قرمز جذب می‌کنند. از این رو انرژی جذب شده ساختار گروههای عاملی خاص در طول موج مشخص به خود انجام شده و منجر به کاهش شدت عبور نور می‌شود و معمولاً به عنوان تابعی از عدد موجی رسم می‌شود. درنتیجه طیف FTIR اطلاعاتی را در مورد ساختمان شیمیایی یک مولکول و نوع گروههای عاملی آن در اختیار می‌گذارد.

سطح ویژه عبارت از مساحت کل جسم متخلخل تقسیم بر جرم جسم است. اساس کار اندازه‌گیری متخلخل و سطح ویژه بر پایه جذب سطحی ماده جذب شده می‌باشد و عمومی‌ترین آنها روش BET است که بر اساس سنجش حجم گاز نیتروژن جذب و واجذب شده توسط سطح ماده در دمای ثابت نیتروژن مایع انجام می‌شود [۲]. آماده‌سازی نمونه‌ها شامل خشک‌کردن و گاز زدایی



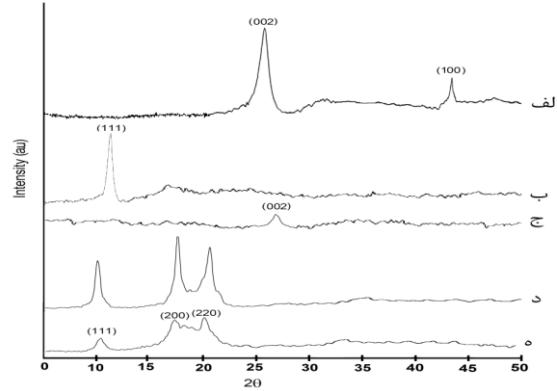
شکل ۲ : مقایسه طیف FTIR

(الف) نanolوله کربنی خالص (ب) اکسید نanolوله کربنی تک دیواره
 (ج) اکسید نanolوله کربنی چند دیواره
 (د) گرافن خالص (ه) اکسیدگرافن (ج) گرافن هامرز
 (د) فولرن خالص (ه) فولرن اصلاح شده

همچنین کاهش شدت پیک ناحیه 1574 cm^{-1} مربوط به ساختار $\text{C}=\text{C}$ است و تغییر آن به سمت جلوتر و در ناحیه 1581 cm^{-1} نشان می‌دهد ساختار گرافن به سمت یک ساختار کربوکسیلیسیونی سوق یافته است و همچنین ساختار هگزاگونال گرافنی در طول فرایند اکسیداسیونی کمی دچار تخریب شده است. این موضوع تطابق بسیار خوبی با نتایج دیگر دارد [۱۰].

اکسیدگرافن بدست آمده از روش هامرز شامل چهار نوع گروه عاملی است که دو گروه آن شامل گروههای اپوکسی ($=\text{O}$) و گروههای هیدرکسید (OH) بر روی صفحات گرافنی و در نقاطی که نقاطی ساختاری ایجاد شده قرار دارند و دو گروه دیگر آن شامل گروههای عاملی آلدهیدی (COH) و گروههای عاملی اسیدی کربوکسیل (COOH) در لبه صفحات گرافنی قرار دارند. از طرفی در اصلاح شیمی سطح، گروههای کربوکسیل بیشتر مورد تغییر قرار می‌گیرند و سایر گروههای عاملی فوق تقریباً ثابت می‌باشند. بنابراین ساختار شیمیائی دو اکسیدگرافن هامرز و اکسیداسیدی گرافن CVD کاملاً با یکدیگر متفاوت است.

در شکل (۲-و) پیک ناحیه 1071 cm^{-1} مربوط به گروههای $\text{C}-\text{O}$ شامل گروههای اپوکسی و هیدرکسید ساختار اکسیدی و پیک ضعیف ناحیه 10581 cm^{-1} و پیک ناحیه 1718 cm^{-1} مربوط به گروههای $(\text{C}-\text{C})$ و $(\text{C}=\text{O})$ است که جز ساختار اصلی و هگزاگونال گرافن محسوب می‌شود [۱۱] که در مجموع ساختار اکسیدگرافن را در گرافن هامرز تایید می‌کنند. که با نتایج بدست آمده در تحقیقات دیگر یکسان می‌باشد [۱۰]. فولرن دارای چهار پیک مشخصه در نواحی 525 cm^{-1} و 575 cm^{-1} و 1180 cm^{-1} و 1430 cm^{-1} می‌باشد [۱۲]. با ملاحظه شکل (۲-ز) وجود پیک در نواحی 1432 cm^{-1} و 1178 cm^{-1} و 576 cm^{-1} و 531 cm^{-1} و 525 cm^{-1} و 1079 cm^{-1} و 1079 cm^{-1} مربوط به ترتیب اکسیدگرافن به پیوند یگانه $(\text{C}-\text{O})$ و پیوند رزونانسی $(\text{C}-\text{O})$ و گروههای هیدرکسید اسیدی (OH) و پیک 1718 cm^{-1} مربوط به پیوند کششی $(\text{C}=\text{O})$ بعنوان یک شاخص محسوب می‌شود که با حضور و ظهور آنها تشکیل گروههای کربوکسیلیک (COOH) تایید می‌شود [۹]. با ملاحظه طیف شکل (۵-۲) ظهور پیک پهن در محدوده 3410 cm^{-1} نشان دهنده پیوند گروههای عاملی (OH) بر ساختار اکسیدگرافن است. همچنین ظهور پیکهای 1718 cm^{-1} و 1218 cm^{-1} بیانگر تشکیل گروههای کربوکسیلیک بر ساختار گرافن می‌باشد که در طول فرایند اکسیداسیون اسیدی انجام شده است.



شکل ۱ : مقایسه طیف XRD

(الف) اکسید نanolوله کربنی (ب) اکسیدگرافن (ج) گرافن خالص
 (د) فولرن خالص (ه) فولرن اصلاح شده

شکل (۱-د) و (۱-ه) طیف XRD فولرن را با ساختار اصلاح شده آن مقایسه می‌کند و ملاحظه می‌شود که نانوساختار فولرن تهیه شده دارای پیکهای شاخص فولرن با ساختار کره‌ای می‌باشد. پس از اعمال فرایند اصلاح خواص سطحی، ساختار فولرن از نظر کریستالی کمی دچار تخریب شده است. نقایص ساختاری بر سطح فولرن در اثر فرایند آسیاب کردن بوجود آمده است.

در طیف سنجی FTIR ساختار نanolوله‌های کربنی دارای پیک شاخص ناحیه 1060 cm^{-1} مربوط به پیوند دو گانه کربن و نشان دهنده ساختار آروماتیکی آن است [V]. در اکسید اسیدی نanolوله‌کربنی پیکهای نواحی 3400 cm^{-1} و 1620 cm^{-1} به ترتیب مربوط به گروههای هیدرکسید اسیدی (OH) و پیوند دوگانه اکسیژن با کربن ($\text{C}=\text{O}$) و پیوند اکسیژن با کربن ($\text{C}-\text{O}$) است [A]. همچنین پیک ناحیه 800 cm^{-1} مربوط به گروههای $(\text{C}-\text{O}-\text{C})$ است. شکل (۲-ب) و (۲-ج) به مقایسه طیف FTIR نanolوله‌کربنی با اکسید اسیدی نanolوله‌های کربنی تک دیواره و چند دیواره می‌پردازد. ملاحظه می‌شود که ظهور پیکهای نواحی 3423 cm^{-1} و 1618 cm^{-1} و 1068 cm^{-1} که مربوط به گروههای کربوکسیل اسیدی که در طول فرایند اکسیداسیون اسیدی نanolوله‌های کربنی بوجود آمده است. این موضوع ساختار اکسیدی نanolوله‌های کربنی تک دیواره و چند دیواره را تایید می‌کند. در فرایند تولید اکسیدگرافن به گروههای عاملی کربوکسیل معروف به ظهور کربوکسیلات است که به لبه‌های گرافن پیوند می‌خورند. در طیف سنجی FTIR از اکسید اسیدی گرافن پیکهای 1218 cm^{-1} و 1180 cm^{-1} و 1079 cm^{-1} و 1079 cm^{-1} به ترتیب مربوط به پیوند یگانه ($\text{C}-\text{O}$) و پیوند رزونانسی ($\text{C}-\text{O}$) و گروههای هیدرکسید اسیدی (OH) و پیک 1718 cm^{-1} مربوط به پیوند کششی ($\text{C}=\text{O}$) بعنوان یک شاخص محسوب می‌شود که با حضور و ظهور آنها تشکیل گروههای کربوکسیلیک (COOH) تایید می‌شود [۹]. با ملاحظه طیف شکل (۵-۲) ظهور پیک پهن در محدوده 3410 cm^{-1} نشان دهنده پیوند گروههای عاملی (OH) بر ساختار اکسیدگرافن است. همچنین ظهور پیکهای 1718 cm^{-1} و 1218 cm^{-1} بیانگر تشکیل گروههای کربوکسیلیک بر ساختار گرافن می‌باشد که در طول

کمی بیش از تک دیواره‌ها است [۱۲]. در نانوچاهات گرافنی مشاهده شد که تاثیر فرایند اکسیداسیون در تخلخل کل مثبت بود و موجب افزایش 35% شده است. اگر چه میزان تخلخل در نانوچاهات خالص گرافنی بسیار کمتر از نanolوله‌ها است ولی این نانوساختارها در مقابل محیط‌های اسیدی مقاومت بیشتری از خود نشان می‌دهند و درنتیجه کمتر دچار تخریب قرار می‌گیرند. یکی از مهمترین دلایل این موضوع تسهیل فرایند شبکه‌ای شدن نanolوله‌های کربنی نسبت به نانوچاهات گرافنی است. بدین ترتیب که با شبکه‌ای شدن نanolوله‌های کربنی گاهاً فضاهای بین شبکه‌ای از مقدار حفره‌های مزو کوچکتر شده و عملًا نوعی تخلخل کاذب را ایجاد می‌کنند و باعث افزایش مقدار تخلخل گزارش شده می‌شوند. وجود چنین تخلخلی بطور کلی می‌تواند مفید واقع شود. نکته قابل توجه نتایج عکس فرایند اعمالدار کردن در نانوساختارهای فولرنی است بدین ترتیب که با اعمالدار کردن فولرن مقدار تخلخل به میزان 18% کاهش نشان می‌دهد. با توجه به اینکه فرایند اعمالدار کردن فولرن در برخی موارد موجب عدم دسترسی به حفره‌های درونی آن می‌شود این موضوع کاهش نسبی تخلخل را در ساختار آن به دنبال خواهد داشت. بر اساس اعداد جدول (۱) اینطور نتیجه می‌شود که فرایند اعمالدار کردن نانوساختارهای کربنی موجب تغییر در مقدار تخلخل شده و درنتیجه خواص سطحی این نانوساختارها را دچار تغییر می‌کند و بنابراین موجب تغییر در مورفوЛОژی آنها می‌شود. ولی نوع و میزان تاثیر این فرایندها علاوه بر اینکه تابع مستقیمی از نوع فرایند است بشدت تابع شکل هندسی اولیه این نانوساختارها نیز می‌باشد. بطوریکه در نanolوله‌های کربنی اثر مثبت با بیشترین تاثیر را می‌گذارد و بر فولرن کربنی اثر منفی با کمترین تاثیر را دارد. همچنین نتیجه می‌شود که فرایندهای اعمالدار کردن موجب تغییر در مورفوLOژی نانوساختارها نیز می‌شود [۱۲].

در این تحقیق از میکروسکوپ AFM تحت اقساط هوا و در مد Tapping برای بررسی زبری سطح نانوساختارهای کربنی استفاده شد. مشاهده شد که . زبری سطح نanolوله‌های کربنی خالص تک دیواره خالص و اعمالدار شده در یک سطح 10×10 میکرومتر مربع به ترتیب حدود $7/8$ و $9/3$ نانومتر می‌باشد. زبری سطح نanolوله‌های کربنی اعمالدار شده بستگی شدیدی به نوع و مقدار گروه‌های عاملی موجود بر سطح آنها دارد که در فرایند اکسیداسیون اسیدی به ضخامت ایجاد شده توسط گروه‌های اکسیدی بر روی سطح نanolوله بستگی پیدا می‌کند بنابراین فرایند اعمالدار کردن موجب افزایش زبری نسبی در سطح نanolوله‌های کربنی تک دیواره شده است. این نتایج تطابق خوبی با نتایج حاصل از آنالیز BET دارد زیرا مقدار BET در اثر فرایند اعمالدار کردن نanolوله‌های کربنی تک دیواره حدود 41% افزایش داشته است که گویای افزایش تخلخل و درنتیجه زبری سطح می‌باشد زیرا زبری سطحی $6/9\%$ افزایش نشان می‌دهد.

زبری سطح نanolوله‌های کربنی در حالت خالص $6/6$ نانومتر و در حالت اعمالدار شده در محیط اسیدی $7/6$ نانومتر محاسبه شده است. این اعداد با نتایج حاصل از آنالیز BET تطابق خوبی دارد بطوریکه فرایند اعمالدار کردن نanolوله‌های کربنی چند دیواره

بعلاوه پیک ناحیه 1178 cm^{-1} پس از اعمال اصلاح ساختاری بر روی فولرن از بین رفته است و پیک ناحیه 1422 cm^{-1} به سمت ناحیه 1378 cm^{-1} میل کرده است تغییر محل این پیک به سمت عقبتر نشان دهنده تخریب در ساختار فولرن می‌باشد زیرا محل پیکها به سمت الگوی طیف FTIR فولرن با ساختار C70 می‌باشد. بنابراین فرایند آسیاب گلوله‌ای موجب ایجاد تخریب در سطح کروی فولرن شده است. این موضوع با مشاهده افزایش نوسانات در شکل (۲-ج) قابل تایید است. زیرا در ساختار فولرن C70 در طول موج‌های کوچکتر مقدار نوسانات طیف FTIR بیشتر می‌شود. همچنین عرضی تر شدن پیک ناحیه 1378 cm^{-1} نشان می‌دهد که ساختار فولرن دچار تخریب شده و بر سطح آن نقاچیص ساختاری بوجود آمده است. این پهنتر شدن استعداد سطح فولرن برای ایجاد پیوند با سایر ترکیبات را مستعدتر می‌کند زیرا این موضوع ناشی از افزایش تعداد سایتها فعال در سطح فولرن می‌باشد که به دلیل شکسته شدن برخی پیوندهای سطحی و ایجاد رادیکالهای فعال بر سطح آن شده است. بدان معنا که تعداد الکترون‌های آزاد بر سطح فولرن بشدت افزایش یافته است و درنتیجه سایتها فعال برای برقراری پیوند با ترکیبات مناسب به خوبی وجود دارد. میزان تخلخل نانوساختارهای کربنی مورد استفاده اندازه گیری و نتایج آن در جدول (۱) آمده است.

جدول ۱ : مقدار BET نانوساختارهای کربنی مورد استفاده

ردیف	نام نمونه	نانوذره	BET (m^2/g)
۱	نانولوله کربنی تک دیواره اعمالدار f-SWNT	نانولوله کربنی تک دیواره اعمالدار	۸۹۵/۶
۲	نانولوله کربنی تک دیواره خالص SWNT	نانولوله کربنی تک دیواره خالص	۶۳۵/۲
۳	نانولوله کربنی چند دیواره اعمالدار f-MWNT	نانولوله کربنی چند دیواره اعمالدار	۶۸۸/۴
۴	نانولوله کربنی چند دیواره خالص MWNT	نانولوله کربنی چند دیواره خالص	۴۳۹/۷
۵	گرافن اعمالدار f-G-CVD	گرافن اعمالدار	۳۰۵/۲
۶	گرافن خالص G-CVD	گرافن خالص	۲۲۵/۷
۷	گرافن هامرز GO-hummers	گرافن هامرز	۳۴۰/۹
۸	فولرن اعمالدار f-C60	فولرن اعمالدار	۱۹۳/۴
۹	فولرن خالص C60	فولرن خالص	۲۳۸/۵

با توجه به جدول (۱) ملاحظه می‌شود که فرایند اعمالدار کردن نanolوله‌های کربنی که در محیط اسیدی انجام می‌شود موجب افزایش سطح ویژه نانوذرات می‌شود. دلیل این موضوع عمدهاً به علت باز شدن دو سر ابتدائی و انتهائی نanolوله‌ها توسط اسید می‌باشد. در اینصورت فضای متخلخل بیشتری شامل سطح داخلی و سطح خارجی نanolوله‌های کربنی در دسترس قرار می‌گیرد و عملًا نانوساختار مورد نظر متخلخلتر می‌شود. با اعمالدار کردن نanolوله‌های کربنی تک دیواره مقدار تخلخل 41% افزایش می‌یابد و از مقدار $895/6 \text{ m}^2/\text{g}$ به $635/2$ می‌رسد. این در حالی است که در نanolوله‌های کربنی چند دیواره فرایند اعمالدار کردن موجب افزایش $56/5\%$ در تخلخل می‌شود. بنابراین علاوه بر اینکه بطور کلی فرایند اکسیداسیون اسیدی موجب افزایش تخلخل در نanolوله‌های کربنی می‌شود این فرایند تاثیر تخریبی بیشتری بر نanolوله‌های چند دیواره دارد و مورفوLOژی سطحی آنرا بیشتر تغییر می‌دهد از این رو است که میزان تخلخل در چند دیواره‌ها

فرایند عاملدار کردن سطحی فولرن مقدار تخلخل را کاهش وی زبری سطح را افزایش می‌دهد. به نظر می‌رسد افزایش کاذب زبری سطح فولرن که ناشی از کاهش اندازه کلاسترهاي فولرنی است مورفولوژي در دسترس این نانوساختار را به سمت یک ساختار نامنظمتر سوق دهد.

۵- نتیجه گیری

اثر فرایند عاملدار کردن بر خواص سطحی نانوذرات تابع نوع نانوذره و هندسه آن می‌باشد. اگرچه فولرن، CNT و گرافن نانوساختار کربنی دارند ولی هندسه صفر، یک و دو بعدی آنها و همچنین تعداد لایه‌ها بر میزان اثر پذیری خواص سطحی از فرایند عاملدار کردن موثر است. بدین ترتیب که کاهش تعداد لایه‌های ساختارهای یک بعدی رفتار آنها را به سمت ساختارهای دو بعدی سوق می‌دهد. در ساختارهای دو بعدی افزایش ترکهای ساختاری و همچنین چین و چروکهای سطحی موجب افزایش زبری سطح گرافن و ناهمسانی در ساختار آن شده و خواص انتقال الکترونی را در سطح آن دچار اختلال می‌کند.

فرایند عاملدار کردن در شرایط یکسان در یک ساختار با تخلخل بالا تاثیر کمتری را بر افزایش زبری سطح داشته است. فرایندهای عاملدار کردن الزاماً موجب افزایش چشمگیر زبری سطح نمی‌شوند و میزان تاثیر گذاری آنها به میزان تخلخل اولیه و خواص سطحی نانوذرات بستگی دارد. اگر سطحی از نانوذره دارای یکنواختی زیاد و تخلخل کم باشد استعداد آن سطح در افزایش تخلخل و زبری بیشتر از سطحی است که خود از تخلخل کافی برخوردار است. مورفولوژی گرافن نانوتخلخل خالص مسطحتر از گرافن نانوتخلخل عاملدار شده است که عمدتاً به دلیل عدم حضور ناقیص ساختاری ناشی از فرایند عاملدار شدن می‌باشد. فرایند عاملدار کردن باعث افزایش یکنواختی ذرات فولرن شده است که ناشی از کوچک شدن کلاسترهاي فولرن است. اگرچه فرایند عاملدار کردن فولرن باعث کاهش تخلخل آن شده است ولی مقدار زبری سطح را افزایش داده است.

۶- منابع

- [1] Y. Chiang, W. H. Lin, Y. C. Chang, The influence of treatment duration on multi-walled carbon nanotubes functionalized by H₂SO₄/HNO₃ oxidation, *Applied Surface Science*, (2011), 2572401.
- [2] International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), Physical Chemistry Division: Commission on Colloid and Surface Chemistry, Manual of Symbols and Terminology for Physicochemical Quantities and Units Appendix II Definitions, Terminology and Symbols in Colloid and Surface Chemistry, Part II: Heterogeneous Catalysis, Pure and Applied Chemistry, 46, (1976), pp.71-90.
- [3] Kuhlmeier, D., Rodda, E., Kolarik, L.O., Furlong, D.N., Bilitewski, U., Application of atomic force microscopy and grating coupler for the characterization of biosensor surfaces Biosensors and Bioelectronics, 18, (2003), pp.925-936.
- [4] Van der Lee MK, Van Dillen AJ, Bitter JH, De Jong KP. Deposition Precipitation for the Preparation of Carbon

موجب افزایش ۵۶/۵% تخلخل شده است که به دنبال آن زبری سطح نیز ۱۵/۱% بیشتر شده است. بنابراین عاملدار کردن موجب افزایش زبری سطح شده و زبری سطح ناشی از افزایش تخلخل می‌باشد. بنابراین وجود یک رابطه مستقیم بین زبری سطح و تخلخل در نانولوله‌ها و به دنبال آن ساختارهای یک بعدی وجود دارد. اگرچه این رابطه بصورت خطی نمی‌باشد بلکه بصورت نمائی با افزایش تخلخل، زبری سطح با شدت کمتری افزایش می‌دهد. زیرا با توجه به نسبت خطی تخلخل در نانولوله‌های کربنی انتظار می‌رود میزان زبری سطح حدود ۵۶/۵% افزایش داشته باشد در حالیکه این مقدار تنها ۱۵/۱% می‌باشد.

مقدار زبری سطح گرافن خالص ۳/۴ نانومتر است [۱۴]. زبری موجود در سطح گرافن باعث تغییر در خواص نوری گرافن می‌شود. متوسط زبری سطح گرافن خالص ۳/۸ نانومتر و برای گرافن عاملدار شده ۴ نانومتر بدست آمده است. بنابراین فرایند عاملدار کردن ۵/۲% زبری سطحی گرافن را افزایش داده است در حالیکه این فرایند در شرایط مشابه زبری نسبی نانولوله‌کربنی تک دیواره را ۶/۹% و نانولوله‌کربنی چند دیواره را ۱۵/۱% افزایش داده است. اگرچه ساختار گرافن خالص ذاتاً دارای چین و چروکهای ناهمسانی است که ناشی از فرایند خنک کردن گرافن پس از اتمام مرحله رشد نانوصفحات گرافنی در فرایند CVD می‌باشد ولی فرایند عاملدار کردن بر شدت و میزان این ناهمسانی افزوده است.

مقدار زبری نسبی گرافن هامرز ۴/۳ نانومتر محاسبه شد. بنابراین با توجه به اینکه گرافن هامرز خود نوعی اکسید گرافن محسوب می‌شود مقدار زبری نسبی آن با اکسید گرافن حاصل از فرایند عاملدار کردن حدود ۰/۳ واحد متفاوت است بطوریکه ساختار گرافن هامرز دارای سطحی زبرتر می‌باشد. وجود ناخالصی‌های مختلف در ساختار گرافیت مثل H, N, CO₂, SiO₂, CH₄, Al₂O₃ موجب می‌شود اکسید گرافن بدست آمده توسعه روش هامرز ساختاری ناخالص‌تر داشته باشد و درنتیجه زبری سطح آن افزایش یابد. تمايل ساختاري گرافن نانوتخلخل عاملدار شده به زبری بیشتر در سطح و همچنین خشن‌تر شدن سطح آن به خوبی قابل استنتاج می‌باشد. بطوریکه زبری سطح گرافن خالص ۴/۲ نانومتر و گرافن عاملدار شده ۴/۴ نانومتر محاسبه شد. فرایند عاملدار کردن گرافن نانوتخلخل موجب افزایش زبری نسبی تا ۷/۴% شده است. این میزان نسبت به سایر نانوساختارهای اخیر کمترین مقدار می‌باشد.

زبری سطح فولرن خالص ۳/۱ نانومتر و زبری سطح فولرن اصلاح شده ۲/۶ نانومتر محاسبه شده است. این موضوع با نتایج آنالیز BET فولرن تطابق ندارد. قبل و بعد از فرایند اصلاح سطحی افزایش یکنواختی در ساختار فولرن اصلاح شده مشهود است که ناشی از کاهش متوسط مسیر آزاد پویش بین ذرات فولرن می‌باشد [۱۵]. بنابراین فضای خالی بین ذرات کاهش یافته است این کاهش فضای خالی بین کره‌های فولرنی موجب افزایش تخلخل کاذب در شبکه فولرن می‌شود که توسط نتایج BET قابل محاسبه نمی‌باشد ولی در زبری سطح فولرن اثر مثبت گذاشته و توسط پروب میکروسکپ AFM شناخته می‌شود. از این رو ملاحظه می‌شود که

Nanofiber Supported Nickel Catalysts, *J. Am. Chem. Soc.*, 127, (2005), pp.13573–13582.

[5] Park O., Jeevananda T., Kim N.H., Kim S., and Hee L.J., Effects of surface modification on the dispersion and electrical conductivity of carbon nanotube/polyaniline composites, *Scripta Materialia*, 60, 7, (2009), pp. 551-554.

[6] Marappan Sathish, and Kun'ichi Miyazawa, Synthesis and Characterization of Fullerene Nanowhiskers by Liquid-Liquid Interfacial Precipitation: Influence of C₆₀ Solubility, *Molecules*, 17, (2012), pp.3858-3865

[7] Sara Safari Kish, Alimorad Rashidi, Hamid Reza Aghabozorg, Leila Moradi, Increasing the octane number of gasoline using functionalized carbon nanotubes, *Appl. Surf. Sci.* 256 (2010) 3472–3477.

[8] C. Hontoria-Lucas, A.J. López-Peinado, J. López-González, D. de,M.L. Rojas-Cervantes, R.M. Martín-Aranda, Study of oxygen-containing groups in a series of graphite oxides, *Phys. Chem. Charact. Carbon*, 33, (1995), pp.1585–1592.

[9] Li C.C., Lin J.L., Huang S.J., Lee J.T., and Chen C.H., A new and acid exclusive method for dispersing carbon multi walled nanotubes in aqueous suspensions, *Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects*, 297, (2007), pp.275-281.

[10] Tessy T.B. and Ramaprabhu S., Investigation of thermal and electrical conductivity of graphene based nanofluids, *Applied Physics* 108, 124308, (2010), pp.1-8.

[11] Masoumeh Akhfash, John A. Boxall, Zachary M. Aman, Michael L. Johns & Eric F. May, " Hydrate formation and particle distributions in gas-water systems", *Chemical Engineering Science*, 104, (2013), pp.177–188.

[12] Susana Iglesias-Groth, Franco Cataldo and Arturo Manchado, Infrared spectroscopy and integrated molar absorptivity of C₆₀ and C₇₀ fullerenes at extreme temperatures, *Mon. Not R. Astron. Soc.*, (2011), pp.1-10.

[13] Chuen-Chang Lin and Chung-Lun Kuo, Effects of Carbon Nanotubes Acid Treated or Annealed and Manganese Nitrate Thermally Decomposed on Capacitive Characteristics of Electrochemical Capacitors, *Nanomaterials*, (2013), pp.1-8.

[14] Jae Young Kim, Ji-Wook Jang, Duck Hyun Youn, Jae Yul Kim, Eun Sun Kim and Jae Sung Lee, Graphene–carbon nanotube composite as an effective conducting scaffold to enhance the photoelectrochemical water oxidation activity of a hematite film, *RSC Adv.*, 2, (2012), pp.9415–9422.

[15] G. K. Wertheim, D. E. Buchanan, E. E. Chaban, and J. E. Rowe, Surface effects in photoemission from alkali-fullerides, *Solid. State Communications*, 83, 785 (1992).